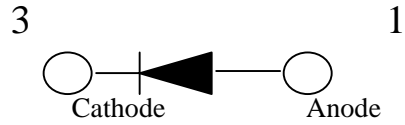




Schottky Diode (FHBAS70)

肖特基二极管



MAXIMUM RATINGS 最大额定值

Rating 额定值	Symbol 符号	Value 值	Unit 单位
Reverse Voltage 反向电压	V_R	70	Vdc
Peak Forward Current 正向峰值电流	I_F	70	mAdc
Peak Forward Surge Current 正向最大浪涌电流 t 1s	$I_{FM(surge)}$	100	mAdc

THERMAL CHARACTERISTICS 热特性

Characteristic 特性	Symbol 符号	Max 最大值	Unit 单位
Total Device Dissipation FR-5 Board(1) $T_A=25$	P_D	225	mW
Total Device Dissipation Alumina Substrate,(2) $T_A=25$ 总耗散功率 氧化铝衬底	P_D	300	mW
Junction and Storage Temperature 结温和储存温度	T_J, T_{stg}	150 , -55 to +150	

DEVICE MARKING 打标

FHBAS70=K1

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 电特性

($T_A=25$ unless otherwise noted 如无特殊说明, 温度为 25)

Characteristic 特性	Symbol 符号	Min 最小值	Max 最大值	Unit 单位
-------------------	-----------	---------	---------	---------

OFF CHARACTERISTICS 截止电特性

Reverse Voltage Leakage Current 反向漏电流($V_R=50Vdc$)	I_R	—	0.1	μAdc
Reverse Breakdown Voltage 反向击穿电压($I_{BR}=10 \mu Adc$)	$V_{(BR)}$	70	—	Vdc
Forward Voltage 正向电压 ($I_F=1mAdc$)	V_F	—	410	mVdc
($I_F=10mAdc$)		—	750	
($I_F=15mAdc$)		—	1000	
Total Capacitance 电容($V_R=0V, f=1.0MHz$)	C_T	—	2	pF



SOT-23 封装外形尺寸 (SOT-23 DIMENSION)

